

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年10月1日(01.10.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/146394 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) C22C 32/00 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01) B22F 1/00 (2006.01)
C22C 12/00 (2006.01) B22F 3/14 (2006.01)
C22C 28/00 (2006.01) B22F 9/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/054712
- (22) 国際出願日: 2015年2月20日(20.02.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-061965 2014年3月25日(25.03.2014) JP
特願 2014-061966 2014年3月25日(25.03.2014) JP
- (71) 出願人: J X 日鉱日石金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町二丁目6番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小井土 由将 (KOIDO Yoshimasa); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場187番地

4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).

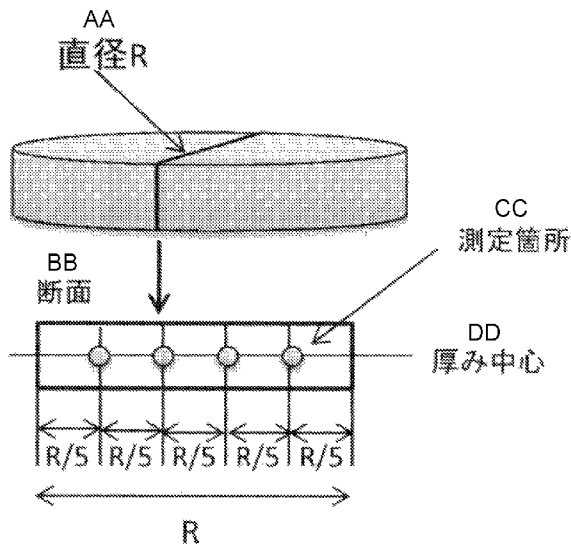
- (74) 代理人: 小越 勇, 外 (OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門2丁目9番14号 発明会館5階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー

[続葉有]

(54) Title: SPUTTERING TARGET OF SINTERED SB-TE-BASED ALLOY

(54) 発明の名称: S b - T e 基金焼結体スパッタリングターゲット

[図1]



AA... DIAMETER, R
BB... CROSS-SECTION
CC... MEASUREMENT PORTION
DD... THICKNESS CENTER

(57) Abstract: A sputtering target of a sintered Sb-Te-based alloy which is a sputtering target having an Sb content of 10-60 at% and a Te content of 20-60 at%, the remainder comprising one or more elements selected from among Ag, In, and Ge and unavoidable impurities, characterized in that the oxides have an average grain diameter of 0.5 μ m or smaller. The sputtering target of a sintered Sb-Te-based alloy has an improved structure so that the occurrence of arcing during sputtering is prevented and that a film to be deposited by the sputtering has improved thermal stability.

(57) 要約: S b 含有量が10~60at%、T e 含有量が20~60at%、残部がA g、I n、G eから選択した一種以上の元素及び不可避的不純物からなるスパッタリングターゲットであって、酸化物の平均粒径が0.5 μ m以下であることを特徴とするS b - T e 基金焼結体スパッタリングターゲット。S b - T e 基金焼結体スパッタリングターゲット組織の改善を図り、スパッタリング時にアーキングの発生を防止すると共に、スパッタリング膜の熱安定性を向上させることを目的とする。



ロツパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))